MOS 管如何检测其是否烧坏了

测试 MOS 好坏只能用指针式万用表才方便

点,测试时选择欧姆 R×10K 档,这时电压可达 10.5V,红笔是负电位,黑笔是正电位。

测试步骤:

MOS 管的检测主要是判断 MOS 管漏电、短路、断路、放大。其步骤如下:

- 1、把红笔接到 MOS 的源极 S 上,黑笔接到 MOS 管的漏极上,好的表针指示应该是无穷大。如果有阻值没被测 MOS 管有漏电现象。
- 2、用一只 100K Ω 200K Ω 的电阻连在栅极和源极上,然后把红笔接到 MOS 的源极 S 上,黑笔接到 MOS 管的漏极上,这时表针指示的值一般是 0,这时是下电荷通过这个电阻对 MOS 管的栅极充电,产生栅极电场,由于电场产生导致导电沟道致使漏极和源极导通,故万用表指针偏转,偏转的角度大,放电性越好。
- 3、把连接栅极和源极的电阻移开,万用表红黑笔不变,如果移开电阻后表针慢慢逐步退回到高阻或无穷大,则 MOS 管漏电,不变则完好。
- 4、然后一根导线把 MOS 管的栅极和源极连接起来,如果指针立即返回无穷大,则 MOS 完好。

論壇內見有燒友說 MOS 管不能用萬用表檢測,其實 MOS 管是可以用萬用表檢測的,MOS 管的 G(柵)極和 D(漏)極 S(源)極之間的電阻是無限大的,因此 MOS 管稱為絕緣柵型場效应管。大家知道這個原理后就開始找 G 極,用表 10K 檔測 3 個極之間的電阻,再將表筆反過來再測一次就會得出一組數據,你會發現有一個極與其它極無論正反都是無限大的,這就是 G 極喇。還有兩個極就好定了,MOS 管內部 D 極與 S 極是有一個寄生 2 極管的,如果測到兩極之間正向導通時就把表筆反過來(這一步很重要),用一個手指按住 G 極,另一只手指去觸摸另外一個極(這樣做是給 MOS 加一個偏壓),其中有一個極是會加上正向電壓使 MOS 觸發的,這個時候 MOS 就會導通,兩極之間電阻就會變得很小,這個極就是 D 極了,如果是手摸到紅筆使 MOS 導通的,這個就是 P 溝的,相反就是 N 溝的。那么只剩下一個極就是 S 極了,好了 3 個極已經確了。

- PS: 1。檢測時要首先把三個電極短路放掉內部的靜電。
- 2。一定要用 10K 檔,因為 MOS 的觸發電壓比較高,只有 10K 檔內部 9V 電池才能使 MOS 觸發
- 3。以上方法是用機械表的方法,數字表測量的話那就當我沒說過。。。。

以上的檢測方法不知是否有誤, 歡迎高手指點

先用万用表 R×10k Ω 挡(内置有 15V 电池),把负表笔(黑)接栅极(G),正表笔(红)接源极(S)。给栅、源极之间充电,此时万用表指针有轻微偏转。再改用万用表 R×1 Ω 挡,将负表笔接漏极(D),正笔接源极(S),万用表指示值若为几欧姆,则说明场效应管是好的。

判断结型场效应管的电极

将

万用表拨至 R×100 档,红表笔任意接一个脚管,黑表笔则接另一个脚管,使第三脚悬空。若发现表针有轻微摆动,就证明第三脚为栅极。欲获得更明显的观察效果,还可利用人体靠近或者用手指触摸悬空脚,只要看到表针作大幅度偏转,即说明悬空脚是栅极,其余二脚分别是源极和漏极。

判断理由: JFET 的输入电阻大于 100M \(\Omega\),并且跨导很高,当栅极开路时空间电磁场很容易在栅极上感应出电压信号,使管子趋于截止,或趋于导通。若将人体感应电压直接加在栅极上,由于输入干扰信号较强,上述现象会更加明显。如表针向左侧大幅度偏转,就意味着管子趋于截止,漏-源极间电阻 RDS 增大,漏-源极间电流减小 IDS。反之,表针向右侧大幅度偏转,说明管子趋向导通,RDS↓,IDS↑。但表针究竟向哪个方向偏转,应视感应电压的极性(正向电压或反向电压)及管子的工作点而定。

注意事项:

- (1) 试验表明,当两手与 D、S 极绝缘,只摸栅极时,表针一般向左偏转。但是,如果两手分别接触 D、S 极,并且用手指摸住栅极时,有可能观察到表针向右偏转的情形。其原因是人体几个部位和电阻对场效应管起到偏置作用,使之进入饱和区。
 - (2) 也可以用舌尖舔住栅极,现象同上。